



宽带隙半导体技术国家重点学科实验室

首页 | 实验室概况 | 科研团队 | 科学研究 | 仪器设备 | 合作交流 | 最新消息 | 通知公告

科学研究

科研奖项

授权专利

论文著作

研究成果



您现在的位置: 首页 >> 科学研究 >> 授权专利 >> 部分国家发明专利 (4)

部分国家发明专利 (4)

序号	专利名称	发明人	授权时间	专利号	专利类型
1	基于m面Al ₂ O ₃ 衬底上半极性GaN的生长方法	郝跃、许晟瑞、周小伟、张进成	20110921	ZL201010155019.5	发明专利
2	基于γ面LiAlO ₂ 衬底上非极性m面GaN的MOCVD生长方法	郝跃、许晟瑞、薛军帅、周小伟、张进成、曹艳荣、蔡冒世、王昊	20111019	ZL201010209568.6	发明专利
3	基于α面6H-SiC衬底上非极性m面GaN的MOCVD生长方法	郝跃、许晟瑞、张进成、周小伟、杨林安、史林玉、王昊、陈珂	2011	ZL201010209324.8	发明专利
4	绝缘栅型源场板异质结构效应晶体管	毛维、郝跃、杨翠、过润秋、张进成、马晓华、许晟瑞	20110601	ZL200810232512.5	发明专利
5	AlGaIn基蓝宝石衬底的紫外LED器件的制作方法	郝跃、杨凌、马晓华、周小伟、李培威	20110406	ZL200910021793.4	发明专利
6	SiC衬底上的多量子阱紫外LED器件及制作方法	郝跃、杨凌、马晓华、周小伟、李培威	20110406	ZL200910021764.8	发明专利
7	基于缺陷边界值变化次数的IC缺陷分类方法	刘红侠、周文、高博	20110209	ZL200910020850.7	发明专利
8	全透明AlGaIn/GaN高电子迁移率晶体管及其制作方法	王冲、郝跃、马晓华、张进成、曹艳荣、杨凌	20110824	ZL201010013536.9	发明专利
9	4H-SiC硅面外延生长石墨烯的方法	张玉明、郭辉、王党朝、张义门、汤晓燕、王悦湖、王德龙	20110427	ZL200910023384.8	发明专利
10	提高4H-SiC基面位错转化率的外延方法	苗瑞霞、张玉明、汤晓燕、张义门	20110715	ZL200910218656.X	发明专利

11	偏移场板结构的4H-SiC PiN/肖特基二极管及其制 作方法	张玉明、陈丰平、 吕红亮、王悦湖、 张林、 郑庆立、宋庆文	20110624	ZL200910022015	发明专 利
12	基于规则拓扑库面向应用 的片上网络生成方法	蔡觉平、刘政、郝 跃、李赞、黄岗、 姚磊、王炼、雷敬 楹、任泽坤、李圣	20111028	ZL201010144088.6	发明专 利

友情链接 [西安电子科技大学微电子学院](#) [中科院半导体所](#) [中科院微电子所](#) [北京大学微电子学系](#) [清华大学信息科学技术学院](#) [中科院上海微系统与信息所](#) [西安中为光电科技公司](#)

本网站版权*西安电子科技大学宽带隙半导体国家重点实验室 技术支持 * 通元动力软件 陕ICP备06007346号 电话：029-88202073
电子邮件：pjma@xidian.edu.cn